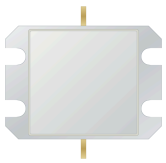
5700–7100 MHz GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü — PSAT 51 dBm (tipik)

LCT-5700-7100-PS51T · 5700–7100 MHz · GaN İçten Eşlenmiş Güç Transistörü.



RF tablosundaki değerler: PSAT 51 dBm (tipik); Güç kazancı 11 dB (tipik); PAE 45 % (tipik). RF test koşulları: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs.

CMW025B

Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın.

Vg: C = 10 µF

RF özellikleri

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.4] V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
Çalışma frekansı	f	5700	-	7100	MHz
Doyum çıkış gücü	-	50.5	51	-	dBm
Güç kazancı	-	10.5	11	-	dB
Eklenen güç verimi	-	40	45	-	%
Güç kazancı düzlüğü	-	-	-	1.5	dB

DC kutuplama ve akım

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Değer	Birim
Dren çalışma gerilimi	-	-	-	-	28	V
Kapı çalışma gerilimi	-	-	-	-	[-3.2, -2.4]	V

Sınır değerler

Sınır değerlerdir; normal çalışma hedefleri değildir.

Parametre	Sembol	Minimum	Tipik	Maksimum	Birim
En yüksek dren-kaynak gerilimi	-	-	-	32	V
En düşük kapı kutuplaması	-	-5	-	-	V
Depolama sıcaklığı	-	-65	-	150	°C
En yüksek giriş gücü	-	-	-	42	dBm

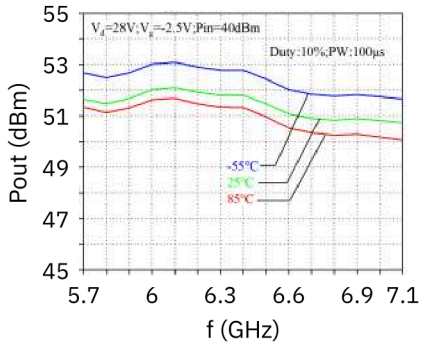
Güncel yayın kaydı · 1.5 · 2026-11-12. Ürün açıklaması veya editoryal içerik güncellendi. Yerine geçtiği revizyon 1.4.

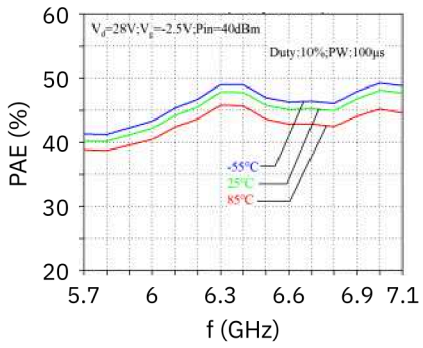
Entegrasyon notları

CMW025B Önce kapı, sonra dren kutuplamasını uygulayın. Kapatırken önce dren kutuplamasını kaldırın. Vg: C = 10 µF G: RF girişi D: RF çıkışı S: Kaynak / toprak

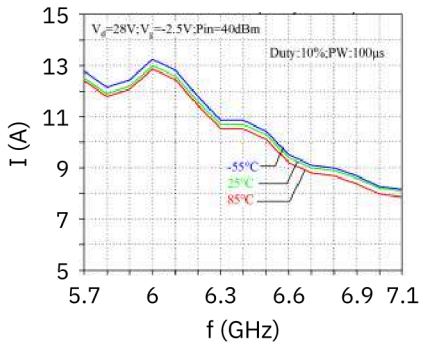
Performans eğrileri

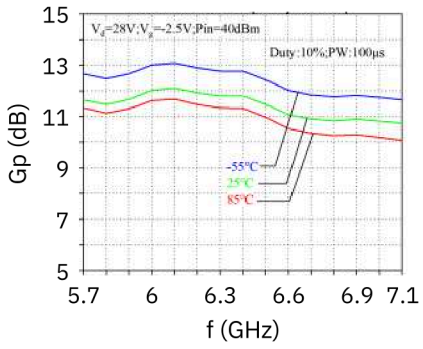
Her şekli, belirtilen çalışma koşullarıyla birlikte değerlendirin.



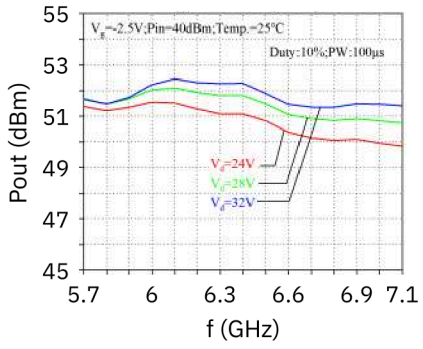


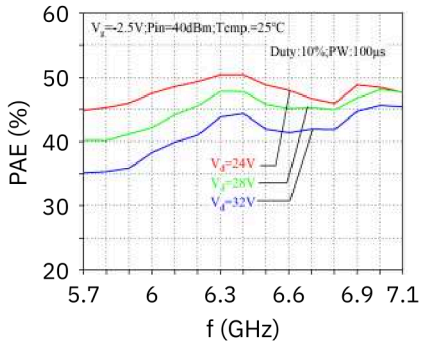
−55°C 25°C 85°C





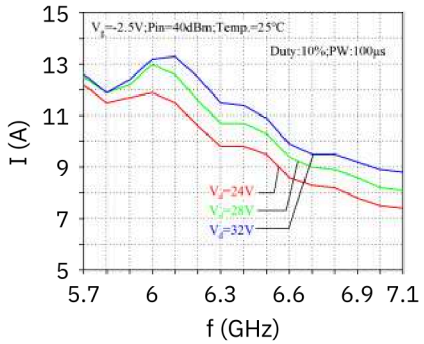
−55°C 25°C 85°C

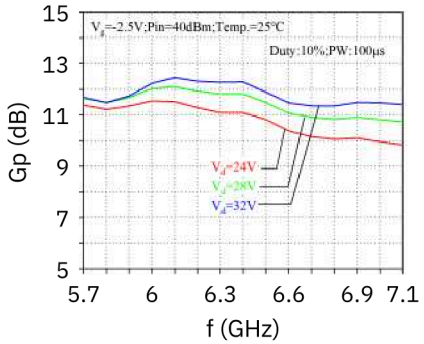


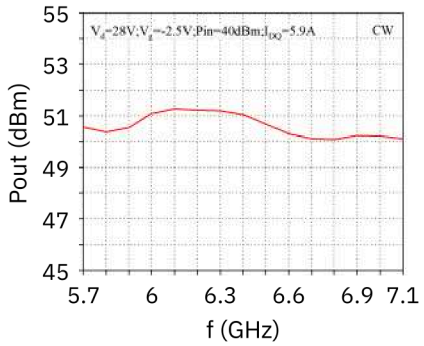


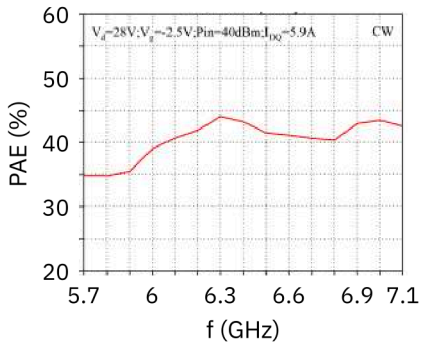
24 V 28 V 32 V

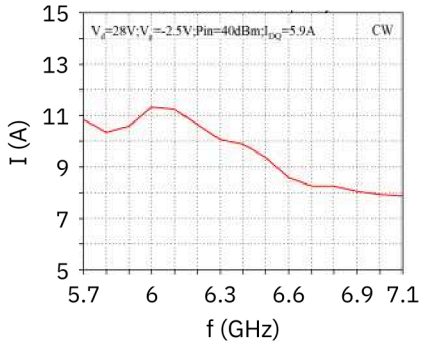
Çıkış gücü; Eklenen güç verimi; Savak akımı; Güç kazancı. Grafikler 1–4: Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; D = 10%; PW = 100 µs; Temp = −55 / +25 / +85°C. Grafikler 5–6: Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs.

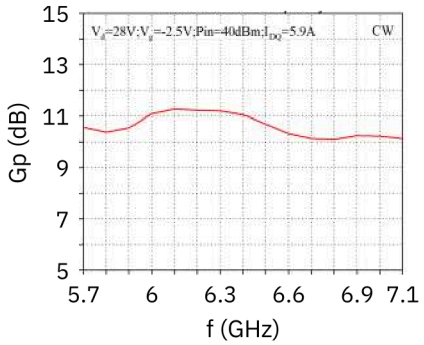




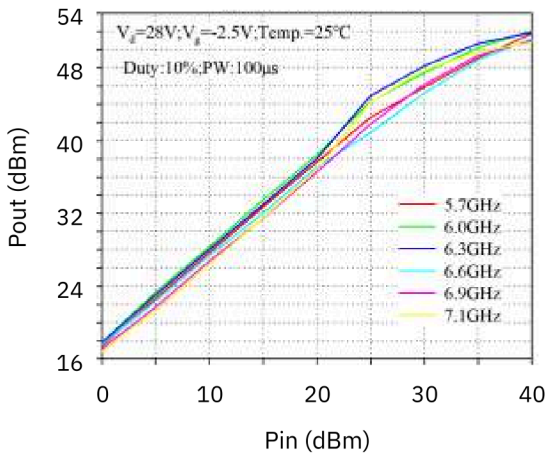


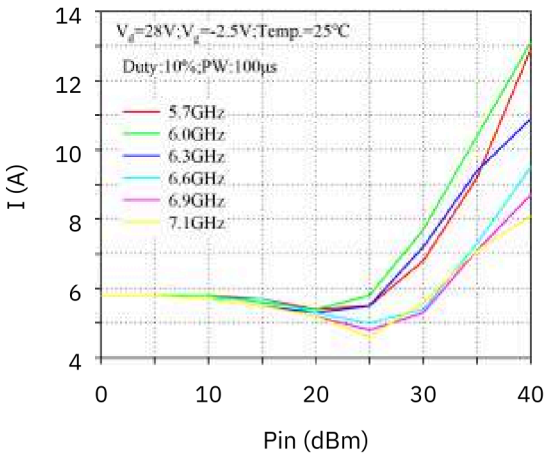






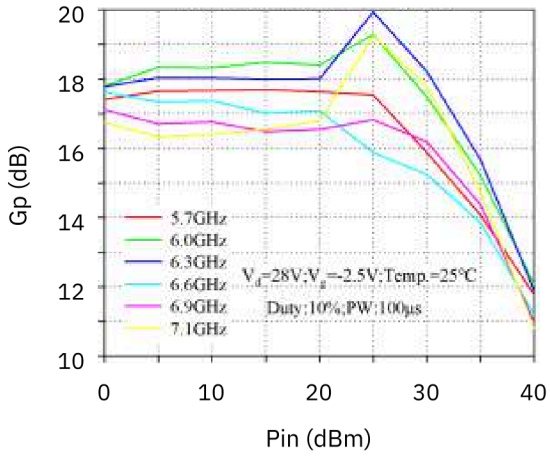
Çıkış gücü; Eklenen güç verimi; Savak akımı; Güç kazancı. Grafikler 1–2: Id, Gp; Vd = 24 / 28 / 32 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs. Grafikler 3–6: Pout, PAE, Id, Gp; Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Pin = 40 dBm; IDQ = 5.9 A; CW.





5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz



5.7 GHz 6.3 GHz 6.9 GHz
6.0 GHz 6.6 GHz 7.1 GHz

Çıkış gücü; Savak akımı; Güç kazancı. Vd = 28 V; Vg = −2.5 V; Temp = +25°C; D = 10%; PW = 100 µs; Pin = 0–40 dBm.

Belge notu

Teknik özellikler revize edilebilir. Tasarımı kesinleştirmeden önce güncel belge revizyonunu ve ürüne özel gereksinimleri LCRF ile doğrulayın. Onaylı teklif ve sipariş belgeleri tedarik edilen yapılandırmayı tanımlar.